

综述评论

高性能双极型集成电路晶体管

傅兴华^①, 陈军宁^②, 童勤义^②

^①贵州大学电子科学系 贵阳 550025; ^②东南大学微电子中心 210018

收稿日期 1992-11-9 修回日期 1993-4-27 网络版发布日期 2009-8-19 接受日期

摘要

本文讨论作为集成电路元件的高性能双极型晶体管的现状和有关的工艺问题。

关键词 [硅双极型集成电路](#) [绝缘介质上硅膜 \(SOI\)](#) [硅锗异质结](#) [异质结双极型晶体管 \(HBT\)](#)
[隔离技术](#)

分类号

HIGH PERFORMANCE BIPOLAR TRANSISTORS FOR INTEGRATED CIRCUIT

Fu Xinghua^①, Chen Junning^②, Tong Qinyi^②

^①Guizhou University, Guizhou 550025; ^②Southeast University, Nanjing 210018

Abstract

The state-of-the-art technologies of bipolar transistors for integrated circuit, in which bipolar transistors based on bulk silicon, silicon-on insulator and SiGe stained layer are included, are discussed.

Key words [Silicon bipolar integrated circuit](#) [SOI](#) [SiGe/Si heterostructure](#) [HBT](#)
[Isolation technology](#)

DOI:

通讯作者

作者个人主页 [傅兴华^①](#); [陈军宁^②](#); [童勤义^②](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(2380KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“硅双极型集成电路”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [傅兴华](#)
 - [陈军宁](#)
 - [童勤义](#)